

SEMICONDUCTOR DEVICE WITH HIGH FREQUENCY AND OUTPUT

PUB. NO.: 59-031042 [JP 59031042 A]
PUBLISHED: February 18, 1984 (19840218)
INVENTOR(s): KOYAMA MASAHIRO
APPLICANT(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP [000601] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)
APPL NO.: 57-141457 [JP 82141457]
FILED: August 12, 1982 (19820812)
INTL CLASS: [3] H01L-023/12; H01L-021/60
JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS — Solid State Components)
JOURNAL: Section: E, Section No. 248, Vol. 08, No. 119, Pg. 1, June 05, 1984 (19840605)

ABSTRACT

PURPOSE: To eliminate a complicated wire bonding process by a method wherein an insulating patch is placed on the upper side of an insulating substrate while each pad corresponding to each metallic bump and each electrode are connected with one another by means of flip-chip-bonding.

CONSTITUTION: Within a conductor layer 16, the metallic bumps 18a, 18b are respectively bonded on the positions corresponding to a base bonding pad 13 and a base electrode 3 while within another conductor layer 17, the metallic bumps 18c, 18d and 18e are respectively bonded on the positions corresponding to an emitter bonding pad 14 and the both side emitter electrodes 11. An insulating patch 15 is placed on the upper side of an insulating substrate 1 while each pad corresponding to each metallic bump and each electrode are connected with one another by means of flip-chip-bonding.

使用後返却願います

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A)

昭59-31042

⑫ Int. Cl.³
H 01 L 23/12
21/60

識別記号

厅内整理番号
7357-5F
6819-5F

⑬ 公開 昭和59年(1984)2月18日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑭ 高周波高出力半導体装置

⑮ 特願 昭57-141457

⑯ 出願 昭57(1982)8月12日

⑰ 発明者 小山正治

伊丹市瑞原4丁目1番地三菱電

機株式会社北伊丹製作所内

⑱ 出願人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑲ 代理人 弁理士 萩野信一 外1名

。半導体チップ基板上に⑩着

。 1 = 18位基板上にAFS成形金属
1" = 70 1-5) 74.70円 570ボルト-ケル

。 機器は前回で...。

この種の半導体装置を高周波高出力トランジスタの場合について説明する。

従来の高周波高出力トランジスタは、第1回に要部を斜視図で示すようになつてゐた。絶縁基板(1)上にはメタライズによりコレクタ電極(2)、ベース電極(3)及び両側のエミッタ電極(4)が形成されている。これら各電極にはリード(2a), (3a)及び(4a)がそればんばん接合されて出されている。両側のエミッタ電極(4)は、コレクタ電極(2)上にすき間をあけてまたがつた接続片(4b)によりばんばん接続されている。コレクタ電極(2)上にはトランジスタチップ(5)が固定され、このチップ(5)上のベースポンディングパッド部(6)とベース電極(3)、エミッタポンディングパッド部(7)とエミッタ電極(4)を金属あるいはアルミ線からなる金属網線(8)でそれぞれワイヤーボンディングしている。

上記従来の高周波トランジスタでは、高周波にさるにしたがい、高周波特性を劣化させる浮遊電荷を減少させるため、チップ(5)上のポンディングパッドはますます小さくなり、このため、金属網

明細書

1. 発明の名称

高周波高出力半導体装置

2. 特許請求の範囲

絶縁基板上に設けられた複数の電極と、これらの電極のうち所定の電極上に固定され、上面に複数のポンディングパッド部が形成された半導体チップと、上記絶縁基板に対し上方側に当たられる絶縁基板と、この絶縁基板の下面に形成された複数の接続導体層と、上記半導体チップの各パッド部及び上記各電極にそれぞれ対応し、上記各接続導体層に固定された複数の金属パンプとを備え、上記絶縁基板を上記絶縁基板の上方側に當て、上記各金属パンプにより上記対応する各パッド部と各電極とをフリップチップポンディングで接続したことを特徴とする高周波高出力半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

この発明は、半導体チップと各電極とをポンディング接続した、高周波高出力半導体装置に関する。

数(8)は細くなつていく。また、高出力となるにしたがい、電流容量の増大に応じ金属網(8)数は幾何級数的に増加し、ワイヤボンディング工程が複雑で面倒になる。また、網数が増加するにしたがい、各金属網(8)を均一に接続することが、極めて困難になり、このため、高周波特性を困害するところが多くなつていた。

この発明は、絶縁基板上の半導体チップと各電極との接続を、絶縁基板の下面に形成した接続導体層に固定した複数の金属バンプによる、フリップチップポンディングにより接続し、高周波高出力であつても、従来のような複雑なワイヤボンド工程を要せず、接続が簡単になり、各電極までのリードインダクタンスを減少でき、高周波特性が向上される高周波高出力半導体装置を提供することを目的としている。

第2図はこの発明の一実施例による高周波高出力トランジスタの斜視図で、図ではフリップチップポンディングのための絶縁基板は上方に外し下面を手前にして示している。ペリリアラ地盤など熱

(3)

が設けられた絶縁基板側を絶縁基板(1)の上方側に当て、各金属バンプにより対応する各パッド部及び各電極とフリップチップポンディングする。こうして、チップ側のパッド部側とベース電極(3)が電気接続され、パッド部側と1対のエミッタ電極(11)とが電気接続される。

第2図では簡単のため、パッド部及び各電極をポンディングする各バンプはそれぞれ1個宛としたが、実際には各バンプ複数個宛が配設されていて並列接続している。

なお、上記絶縁基板側に形成した接続導体層側、即ち、接続用だけではなく、簡単な整合回路として構成すれば、さらに利得の向上及び広帯域化をも実現することができ、入出力インピーダンスを、高周波における信号源及び負荷インピーダンスである50Ωにまで高めることも可能である。

また、上記実施例では、高周波高出力半導体装置として、高周波高出力トランジスタに適用した場合を示したが、これに限らず他の種の高周波高出力の半導体装置にも適用できるものである。

伝導性の良い絶縁基板(1)の上面に、メタライズによるコレクタ電極(2)が設けられ、また、ベース電極(3)及び両側1対のエミッタ電極(11)が形成されている。^{形成}(11a)はエミッタ電極時にそれぞれはんだ接合されたリード、(11b)はコレクタ電極(2)上に固定されたトランジスタチップで、上面にベースポンディングパッド部(14)とエミッタポンディングパッド部(15)とが形成されている。

次に(4)はアルミナ、あるいはガラスなど絶縁材からなる絶縁基板で、絶縁基板(1)上のチップ側及び各電極部に上方から当てられる。この絶縁基板(4)の下面には、メタライズなどにより接続導体層側、即ち、側が形成されている。導体層側には、ベースポンディングパッド部(14)に対応する位置に金属バンプ(18a)を、ベース電極(3)に対応する位置に金属バンプ(18b)を固定してある。また、導体層側には、エミッタポンディングパッド部(15)に対応する位置に金属バンプ(18c)を、両側の各エミッタ電極(11)に対応する位置に金属バンプ(18d)及び(18e)をそれぞれ固定してある。このように下面に各金属バンプ

(4)

以上のように、この発明によれば、絶縁基板の下面に形成した接続導体層に、半導体チップの各パッド部と各電極とにそれぞれ対応する複数の金属バンプを固定し、この各金属バンプにより、絶縁基板上の半導体チップと各電極とをフリップチップポンディングにより接続したので、高周波高出力であつても、従来のような複雑なワイヤボンド工程を要せず、電極までのリードインダクタンスを減少することができ、高周波特性が向上される。また、従来のように高出力に伴う熱発生した多数本の金属網の使用による断線事故がなくなり、信頼性が向上される。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の高周波高出力トランジスタの要部を示す斜視図、第2図はこの発明の一実施例による高周波高出力トランジスタの要部を、絶縁基板は外して下面を現して示す斜視図である。

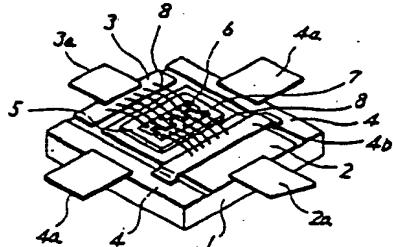
1…絶縁基板、2…コレクタ電極、3…ベース電極、11…エミッタ電極、12…トランジスタチップ、13…ベースポンディングパッド部、14…

(5)

特函昭59-31042 (9)

エミッタポンディングバッド部、15…絶縁当板、
 16, 17…接続導体層、18a～18e…金属バンブ
 ン等、図中同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 福野信一(外1名)



第2回 金原 (112-13)

— 2000 (P.W. +. 1992) 2000

$N^{\prime \prime} - 2t^{\prime \prime} : F^{\prime \prime} \rightarrow$
 $1^{\prime \prime} \rightarrow t^{\prime \prime} - \frac{1}{3}d$

(7)

